

## Leica e-beam 電子束直寫系統注意事項:

1. 此機台開放等級為B3級，使用者經訓練且通過考核後可自行操作。
2. 欲申請使用者，須先通過Track及In-Line考核後，才可以申請考核（劉正財先生ext:7649或7439；電子信箱：andyliu@narlabs.org.tw），一旦Track或In-Line SEM被停權，則同時取消Leica e-beam 電子束直寫系統使用權。
3. 為維持委託代工出貨進度順暢，於上班時段（上午8：00至下午5：00）NDL員工有優先使用權。如欲在上班時段使用機台，必須先徵求機台負責工程師同意之後，方可使用。
4. 每次使用須詳實填寫機台使用紀錄表，如有闕漏不實者，將視情節依NDL規定議處。
5. 阻劑塗佈、顯影及線寬量測，皆由使用者自行操作。
6. 曝光檔案名稱與內容請自行牢記，NDL不負記憶檔案名稱與內容之責任。
7. 曝光檔案名稱請遵照下列格式命名：
  - a. 學校系所\_人名\_元件\_任意名稱  
例：NCTUEE\_JTLIU\_FINFET\_PAD
  - b. 單位名稱\_人名\_元件\_任意名稱  
例：NDL\_JTLIU\_TFT\_GATE
8. 為活化硬碟空間，機台每年8月第一週進行曝光檔案清理，使用者請於7月底前將欲保留的檔案名稱列表繳交機台負責人，若因未繳交或是表列遺漏以致檔案遭刪除，使用者請自負責任，不得異議。
9. 曝多層圖形，請先作零層曝光（ZEROMARK.SLS）與蝕刻（蝕刻深度1-2 $\mu$ m）。多層對準精度  $\leq \pm 80\text{nm}$ 。
10. 標準製程基材為單面拋光6吋單平邊矽晶圓，平邊長度57.5 mm（晶圓規格需與NDL規格相同）。
11. 標準製程：A:負型阻劑為NEB22-A2負型阻劑，光阻厚度360nm，解析度 iso-line 100nm ( $\pm 10\%$ )。  
B. 正型阻劑為TDUR-P015正型阻劑，光阻厚度410nm，解析度 iso-trench 及 iso-hole 200nm ( $\pm 10\%$ )。
12. 若無特殊製程需求，嚴禁使用其他基材或阻劑。如欲使用其他基材或阻劑，須提出相關之書面說明，並經機台負責人核准，方可使用。

機台負責人：

劉正財(分機 7649)